

NUBIC知的財産情報開示

開示日： 2014年03月04日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

	NUBIC管理番号: <input type="text" value="2013000007"/> 整理番号 <input type="text" value="11778"/> 担当者 <input type="text" value="松岡 義人"/>
表 題	<input type="text" value="磁化同軸プラズマガンにおけるプラズモイド生成の効率化"/>
技術分野	<input type="text" value="機械・加工"/> <input type="text" value="電気・電子"/>
適用製品	<input type="text" value="金属、炭素などの薄膜生成装置およびイオン注入装置"/>
目 的	<input type="text" value="高融点金属を含む合金薄膜の高速生成や炭素系薄膜の形成、また、イオン注入や熱プラズマへの粒子供給等への応用が進められている「磁化同軸プラズマガン」について、装置の複雑化や消費電力の増加なく、生成される磁化プラズモイドの生成効率を向上させることを目的とした開発である。"/>
技術概要	<input type="text" value="磁化同軸ガンの外部電極に磁束保持導体外殻を設けることで、磁化磁場の利用効率を向上させ、また、その形状設計を適切に行うことで、生成されるプラズモイドの再現性を向上させることを実現した。"/> <input type="text" value="本発明は、基本的には導電率の高い導体外殻を外部電極上に設けるというパッシブな制御手法であり、装置の複雑化や消費電力の増大等なしに、磁化プラズモイド生成効率の向上を実現した。このため、製膜等の応用において、連続的なプラズモイド生成・射出を要するケースで、省電力化などの効果が期待されるとともに、絶縁破壊位置やタイミングの再現性が向上することにより、より均一性の高いプラズモイド生成が実現している。"/>

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申込みください。

(FAX, e-mail, 郵送いずれでも可。)

各担当コーディネーターからご連絡を差し上げます。

面談希望日時	<input type="text"/>		
(ふりがな) 氏 名	<input type="text"/>		
会社名	<input type="text"/>		
所 属	役職 <input type="text"/>		
電話番号	<input type="text"/>	FAX番号	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		
連絡事項	<input type="text"/>		



【申込み・問い合わせ先】

日本大学産官学連携知財センター(NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館

TEL:03-5275-8139 FAX:03-5275-8328 E-mail:nubic@nihon-u.ac.jp